

	<p>SI3585DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3585DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SI3585DV-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 35310 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3585DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35310 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 2A, 1.5A 830mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A, 1.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI3585
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3585DV-T1-GE3CT

SI3585DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3585DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3585DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3585DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3585DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3586DS-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI3585DV-T1 VISHAY SI3585DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3586DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2.9A 6TSOP</p>
 <p>SI3585DV VISHAY SI3585DV VISHAY</p>	 <p>SI3586DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2.9A 6TSOP</p>	 <p>SI3586DV VISHAY SI3586DV VISHAY</p>	 <p>SI3585DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ⚙ SI3495DV | ↔ SI3495DV-T1-E3 | ⇒ SI3495DV-T1-E3 | D SI3495DV-T1-GE3 | ⇒ SI3495DV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3499DV-T1-E3 | ⚙ SI3499DV-T1-E3 | D SI3499DV-T1-GE3 | ⇒ SI3499DV-T1-GE3 | ⇒ SI3500-A-GM |
| ⚙ SI3529DV-T1-GE3 | ⊣ SI3529DV-T1-GE3 | ⚙ SI3552DV | ↔ SI3552DV-T1 | ⇒ SI3552DV-T1-E3 |
| D SI3552DV-T1-E3 | ⚙ SI3552DV-T1-GE3 | ⊣ SI3552DV-T1-GE3 | ⚙ SI3585CDV | ⇒ SI3585CDV-T1-GE3 |
| ⇒ SI3585CDV-T1-GE3 | ↔ SI3585DV | ⚙ SI3585DV-T1 | ⊣ SI3585DV-T1-E3 | ⇒ SI3585DV-T1-E3 |
| ↔ SI3585DV-T1-GE3 | ⇒ SI3586DS-TI-E3 | D SI3586DV | ⚙ SI3586DV-T1-E3 | ⊣ SI3586DV-T1-E3 |
| ⚙ SI3586DV-T1-GE3 | D SI3586DV-T1-GE3 | ⇒ SI3588DV | ↔ SI3588DV-T1-E3 | ⇒ SI3588DV-T1-E3 |
| ⊣ SI3588DV-T1-GE3 | ⚙ SI3588DV-T1-GE3 | ↔ SI3590DV-T1-GE3 | ⇒ SI3590DV-T1-GE3 | ⇒ SI3801DV-T1 |
| ⚙ SI3803DV-T1 | ⊣ SI3805DV-T1 | ⚙ SI3805DV-T1-E3 | D SI3805DV-T1-E3 | ⇒ SI3812DV-T1-GE3 |
| ↔ SI3812DV-T1-GE3 | ⚙ SI3850ADV-T1-E3 | ⊣ SI3850ADV-T1-E3 | ⚙ SI3850ADV-T1-GE3 | ⇒ SI3850ADV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited